
	<h2>SI3879DV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3879DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3879DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 68276 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3879DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	68276 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 5A (Tc) 2W (Ta), 3.3W (Tc) Surface
Serie	LITTLE FOOT®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 3.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	480pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3879DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3879DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3879DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3879DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3900DV VISHAY SI3900DV VISHAY</p>	 <p>SI3867DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>	 <p>SI3879DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3879DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>
 <p>SI3900DV-T1-E3 Vishay / Spectrol MOSFET 2N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p>SI3867 VISHAY</p>	 <p>SI3867DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>	 <p>SI3867DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

# SI3851DV	↔ SI3851DV-T1	⇒ SI3851DV-T1-E3	D SI3851DV-T1-E3	⇒ SI3851DV-T1-GE3
↳ SI3853DV-T1-E3	# SI3853DV-T1-E3	D SI3861BDV-T1-GE3	⇒ SI3861BDV-T1-GE3	⇒ SI3861DV-NL
# SI3861DV-T1-E3	↳ SI3863BDV-T1-GE3	# SI3863DV-T1-E3	↔ SI3863DV-T1-GE3	⇒ SI3865BDV-T1-E3
D SI3865BDV-T1-E3	# SI3865CDV-T1-GE3	↳ SI3865CDV-T1-GE3	# SI3865DV-T1	⇒ SI3865DV-T1-E3
⇒ SI3865DV-T1-GE3	↔ SI3867DV-T1-E3	# SI3867DV-T1-E3	↳ SI3867DV-T1-GE3	⇒ SI3867DV-T1-GE3
↔ SI3879DV-T1-E3	⇒ SI3900DV	D SI3900DV-T1-E3	# SI3900DV-T1-E3	↳ SI3900DV-T1-GE3
# SI3900DV-T1-GE3	D SI3905DV-T1	⇒ SI3905DV-T1-E3	↔ SI3905DV-T1-E3	⇒ SI3905DV-T1-GE3
↳ SI3905DV-T1-GE3	# SI3909DV-T1	↔ SI3909DV-T1-E3	⇒ SI3909DV-T1-E3	⇒ SI3909DV-T1-GE3
# SI3909DV-T1-GE3	↳ SI3911DV	# SI3911DV-T1	D SI3911DV-T1-E3	⇒ SI3911DV-T1-E3
↔ SI3911DV-T1-G33	# SI3911DV-T1-GE3	↳ SI3911DV-T3-E3	# SI3915DV	⇒ SI3915DV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited